

H10 半導体装置；他に分類されない電氣的
固体装置 [2023.01]

H10B 電子記憶装置 [2023.01]

注

このサブクラスでは、セクション C の注 (3) の周期表中に示された I-VIII 族のシステムが用いられる。

サブクラス内の索引

揮発性記憶装置

SRAM.....	10/00
DRAM.....	12/00
不揮発性記憶装置	
ROM;PROM;EPROM.....	20/00

フロ - ティングゲ - トを含む EEPROM.....	41/00
電荷トラッピングゲ - ト絶縁体を含む EEPROM	43/00
強誘電性のメモリトランジスタを含む FeRAM..	51/00
強誘電性のメモリキャパシタを含む FeRAM.....	53/00
MRAM.....	61/00
抵抗変化メモリ.....	63/00
他の EPROM.....	69/00
複数の装置の組立体.....	80/00
他の電子記憶装置	
このサブクラスの他のグル - プに分類されない主題事項	99/00

揮発性記憶装置 [2023.01]

10/00	スタティックランダムアクセスメモリ [SRAM] 装置 [2023.01]
10/00 371	・バイボ - ラ ,MOS 以外のスタティックランダムアクセスメモリ構造
10/00 401	・接合型または SIT トランジスタメモリ
10/10	・バイボ - ラ構成部品からなる SRAM 装置 [2023.01]
12/00	ダイナミックランダムアクセスメモリ [DRAM] 装置 [2023.01]
12/00 601	・1MOS トランジスタ 1 キャパシタ型 DRAM
12/00 611	・キャパシタ構造に特徴のあるもの
12/00 615	・プレ - ナ型キャパシタ
12/00 621	・スタック型キャパシタ
	A 横方向にフィンを形成しているもの
	B 縦方向の面を利用するもの
	C ・ストレ - ジ電極にくぼみ面を有するもの、例、クラウン型または CUP 型キャパシタ
	Z その他のスタック型キャパシタ、例、単純スタック型またはスタック型の各種変形
12/00 625	・トレンチ型キャパシタ
	A 基板をセルプレ - トとして用いるもの
	B 基板をストレ - ジノ - ドとして用いるもの
	C トレンチ内にセルプレ - トとストレ - ジノ - ドを各々独立に設けるもの
	Z その他のトレンチ型キャパシタ
12/00 631	・空乏層容量を利用したキャパシタ
12/00 651	・キャパシタ絶縁膜に特徴のあるもの、例、絶縁膜材料に特徴のあるもの
12/00 661	・その他のキャパシタ
12/00 671	・トランジスタ構造に特徴のあるもの
	A 縦型トランジスタ
	B ・溝型トランジスタ

C SOI 上にトランジスタを形成したものの

Z その他のトランジスタ

12/00 681	・その他、例、レイアウト、に特徴のあるもの
A	ワ - ド線のレイアウト、構造または材料に特徴のあるもの
B	ビット線のレイアウト、構造または材料に特徴のあるもの
C	接地線または電源線のレイアウト、構造または材料に特徴のあるもの
D	素子分離構造に特徴のあるもの
E	チップ全体またはそれに近いレイアウトプランに特徴のあるもの
F	周辺回路部の構造またはレイアウトに特徴のあるもの
G	・センスアンプに特徴のあるもの
Z	その他
12/00 691	・誤動作防止に特徴のあるもの
12/00 801	・1MOS トランジスタ 1 キャパシタ型以外の DRAM
12/00 821	・MOS 他のトランジスタからなる DRAM
12/00 841	・バイボ - ラ ,MOS 以外のダイナミックランダムアクセスメモリ構造
12/00 861	・接合型または SIT トランジスタメモリ
12/10	・バイボ - ラ構成部品からなる DRAM 装置 [2023.01]
不揮発性記憶装置 [2023.01]	
20/00	読み出し専用メモリ [ROM] 装置 [2023.01]
20/00 421	・バイボ - ラ ,MOS 以外の不揮発性メモリ
20/00 437	・接合型または SIT トランジスタメモリ
20/10	・バイボ - ラ構成部品からなる ROM 装置 [2023.01]
20/20	・電界効果構成部品からなる書き込み可能な ROM[PROM] 装置 (H10B20/10 が優先) [2023.01]
20/25	・一回のみ書き込み可能な ROM[OTPRO] 装置、例、電氣的に溶断可能なリンクを用いるもの [2023.01]
41/00	フロ - ティングゲ - トを含む電氣的消去・書き込み可能な ROM[EEPROM] 装置 [2023.01]
41/10	・上から見たレイアウトに特徴のあるもの [2023.01]
41/20	・三次元配置、例、異なる高さに配置されたセル、に特徴のあるもの [2023.01]
41/23	・異なる高さのソ - スとドレインを有するもの、例、傾斜チャネルを有するもの [2023.01]
41/27	・垂直部分を含むチャネル、例、U 字型チャネル [2023.01]
41/30	・メモリコア領域に特徴のあるもの [2023.01]
41/35	・セル選択トランジスタを有するもの、例、NAND[2023.01]
41/40	・周辺回路領域に特徴のあるもの [2023.01]
41/41	・メモリ領域にセル選択トランジスタを有するもの、例、NAND[2023.01]
41/42	・周辺セルおよびメモリセルの同時製造 [2023.01]

41/43	…周辺トランジスタを一種類のみ含むもの [2023.01]	63/00	抵抗変化メモリ装置, 例. 抵抗 RAM[ReRAM] 装置 [2023.01]
41/44	…コントロールゲート層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2023.01]	63/10	・相変化 RAM[PCRAM,PRAM] 装置 [2023.01]
41/46	…ゲート間誘電体層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2023.01]	69/00	ゲル - プ H10B41/00-H10B63/00 に包含されない, 消去可能でプログラム可能な ROM[EPROM] 装置, 例. 紫外線による消去可能でプログラム可能な ROM[UVEPROM] 装置 [2023.01]
41/47	…フロティングゲート層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2023.01]	80/00	このサブクラスに包含される, 少なくとも 1 つの記憶装置を備える, 複数の装置の組立体 [2023.01]
41/48	…トンネル誘電体層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2023.01]	99/00	このサブクラスの他のゲル - プに分類されない主題事項 [2023.01]
41/49	…異なる種類の周辺トランジスタを含むもの [2023.01]	99/00 301	・マトリクス半導体装置
41/50	・コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2023.01]	99/00 441	・不揮発性 RAM
41/60	・コントロールゲートがド - プ領域であるもの, 例. 単層ポリメモリセル [2023.01]	99/00 449	・有機メモリ
41/70	・フロティングゲートが複数の構成部品で共有される電極であるもの [2023.01]	99/00 451	・他の半導体メモリ
43/00	電荷トラッピングゲート絶縁体を含む EEPROM 装置 [2023.01]	99/00 461	・半導体チップ内メモリ
43/10	・上から見たレイアウトに特徴のあるもの [2023.01]	99/00 471	・回路配置等の構成
43/20	・三次元配置, 例. 異なる高さに配置されたセル, に特徴のあるもの [2023.01]	99/00 481	・周辺回路
43/23	・異なる高さのソースとドレインを有するもの, 例. 傾斜チャネルを有するもの [2023.01]	99/00 491	・誤動作防止
43/27	…垂直部分を含むチャネル, 例. U 字型チャネル [2023.01]	99/00 495	・メモリモジュール
43/30	・メモリコア領域に特徴のあるもの [2023.01]		
43/35	…セル選択トランジスタを有するもの, 例. NAND[2023.01]		
43/40	・周辺回路領域に特徴のあるもの [2023.01]		
43/50	・コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2023.01]		
51/00	強誘電性のメモリトランジスタを含む強誘電体メモリ [FeRAM] 装置 [2023.01]		
51/10	・上から見たレイアウトに特徴のあるもの [2023.01]		
51/20	・三次元配置, 例. 異なる高さに配置されたセル, に特徴のあるもの [2023.01]		
51/30	・メモリコア領域に特徴のあるもの [2023.01]		
51/40	・周辺回路領域に特徴のあるもの [2023.01]		
51/50	・コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2023.01]		
53/00	強誘電性のメモリキャパシタを含む強誘電体メモリ [FeRAM] 装置 [2023.01]		
53/10	・上から見たレイアウトに特徴のあるもの [2023.01]		
53/20	・三次元配置, 例. 異なる高さに配置されたセル, に特徴のあるもの [2023.01]		
53/30	・メモリコア領域に特徴のあるもの [2023.01]		
53/40	・周辺回路領域に特徴のあるもの [2023.01]		
53/50	・コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2023.01]		
61/00	磁気メモリ装置, 例. 磁気抵抗 RAM[MRAM] 装置 [2023.01]		